

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 03-006808  
 (43)Date of publication of application : 14.01.1991

(51)Int.CI. H01G 9/02  
 H01G 9/04  
 H01G 9/24

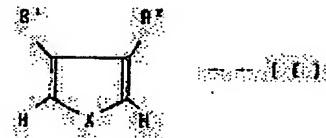
(21)Application number : 01-142718 (71)Applicant : SHOWA DENKO KK  
 (22)Date of filing : 05.06.1989 (72)Inventor : NAITO KAZUMI  
 NAKAMURA HIDENORI

## (54) MANUFACTURE OF SOLID ELECTROLYTIC CAPACITOR

## (57)Abstract:

PURPOSE: To shorten electrolytic polymerization time and to desirably reduce loss coefficient by processing valve operation metal having a dielectric oxide film layer on a surface with oxidizer, and then forming a semiconductor layer on the film layer by electrolytic polymerization in electrolyte containing specific monomer.

CONSTITUTION: After valve operation metal having a dielectric oxide film layer on a surface is processed with oxidizer, and a semiconductor layer of solid electrolyte is formed on the film by electrolytic polymerization in electrolyte containing monomer represented by a formula (I). In the formula (I), R1, R2 are alkyl group, alkoxy group or H, X is O, S or NR<sub>3</sub>, and R3 is alkyl group or H. When the metal is dipped in the electrolyte to be electrolytically polymerized, electrolytic polymerization and simultaneously chemical polymerization occur. As a result, the electrolytic polymerization time is shortened. Further, the polymerization occurs when the chemically polymerized part is very small, and a boundary resistance between the chemical polymerization layer and the electrolytic polymerization layer becomes vary small, and the DF value of a capacitor can be maintained desirably low.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision  
of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's  
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## ⑪ 公開特許公報 (A)

平3-6808

⑤Int.Cl.<sup>5</sup>H 01 G 9/02  
9/04  
9/24

識別記号

3 3 1  
3 0 1  
C

庁内整理番号

7924-5E  
7924-5E  
7924-5E

④公開 平成3年(1991)1月14日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

②発明の名称 固体電解コンデンサの製造方法

③特願 平1-142718

④出願 平1(1989)6月5日

⑤発明者 内藤 一美 東京都大田区多摩川2-24-25 昭和電工株式会社総合技術研究所内

⑥発明者 中村 英則 東京都大田区多摩川2-24-25 昭和電工株式会社総合技術研究所内

⑦出願人 昭和電工株式会社 東京都港区芝大門1丁目13番9号

⑧代理人 弁理士 寺田 寛

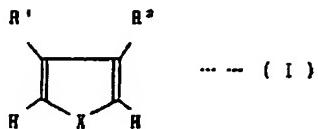
## 明細書

## 1. 発明の名称

固体電解コンデンサの製造方法

## 2. 特許請求の範囲

(1) 表面に説電体強化皮膜層を有する並作用金属を酸化剤で処理した後、一般式(I)



$R^1$ 、 $R^2$ はアルキル基、アルコキシル基又は  
 $H$ 、 $X$ はO、S又は $NR^3$ 。 $R^3$ はアルキル基又  
はH

で表わされるモノマーを含む電解液中で電解重合によって前記説電体強化皮膜層上に半導体層を形成することを特徴とする固体電解コンデンサの製造方法。

## 3. 発明の詳細な説明

## 【産業上の利用分野】

本発明は、高周波性能の良好な固体電解コンデンサの製造方法に関する。

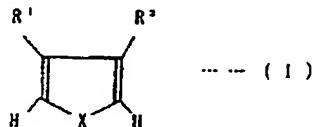
## 【従来の技術】

固体電解コンデンサは表面に説電体強化皮膜を有するアルミニウム、タンタル、ニオブ等の並作用金属に固体電解質である半導体を付着した構造を有している。

従来、この種の固体電解コンデンサの固体電解質には、主に硝酸マンガンの熱分解により形成される二酸化マンガンが用いられている。しかし、この熱分解の際に必要な高熱と発生する $NO_x$ ガスの酸化作用等によって説電体であるアルミニウム、タンタルなどの説電体強化皮膜の損傷が起り、そのため耐電圧は低下し、漏れ電流が大きくなり、説電特性を劣化させる等大きな欠点がある。また再化成という工程も数回必要になる。

これらの欠点を補うために高熱を付加せずに固体電解質を形成する方法、つまり高電導性の高分子半導体材料を固体電解質とする方法が試みられ

ている。その例としては、下記の一般式(I)で表わされるモノマーを重合して得られる高分子化合物にドーパントをドープして得られる電導性高分子化合物を固体電解質とする固体電解コンデンサが知られている。

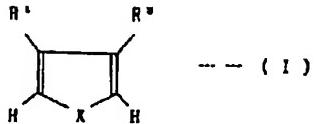


$R^1, R^2$ はアルキル基、アルコキシル基又はH、XはO、S又はNR³、R³はアルキル基又はH

又、この種の電導性高分子化合物を固体電解質とする固体電解コンデンサの製造方法として、上記一般式(I)で表わされるモノマーを溶解した溶液中で電解重合することによって作製する方法も知られている。

〔発明が解決しようとする課題〕

されたもので表面に誘電体酸化皮膜層を有する並作用金属を酸化剤で処理した後、一般式(I)



$R^1, R^2$ はアルキル基、アルコキシル基又はH、XはO、S又はNR³、R³はアルキル基又はH

で表わされるモノマーを含む電解液中で電解重合によって誘電体酸化皮膜層上に固体電解質である半導体層を形成する固体電解コンデンサの製造方法にある。

以下、本発明について詳細に説明する。

本発明において固体電解コンデンサの陽極として用いられる並作用金属としては、例えばアルミニウム、タンタル、ニオブ、チタン及びこれらを基質とする合金等、並作用を有する金属がいずれ

しかしながら、上述した電解重合によって固体電解質を形成する場合、一般に誘電体酸化皮膜全層に固体電解質層を形成するには長時間を必要としている。この欠点を無くすために誘電体酸化皮膜近辺に外部電極を多段配置して、外部電極からの重合開始によって時間短縮を図っているものの、或いは化学重合等により誘電体酸化皮膜層上に電導性高分子化合物層を形成し、この層を見掛けの外部電極として電解重合時間を短縮しているものが考えられている。

ところが前者の手法では、外部電極の配置個数に限りがあるため充分な重合時間を短縮する目的には使用できず、又、後者の手法では、先に化学重合して形成した電導性高分子化合物層が存在するため、後に電解重合した層との界面抵抗により作製した固体電解コンデンサの損失係数（以下DFと称する）が大きくなるという問題点があった。

〔課題を解決するための手段〕

本発明は、上述した問題点を解決するためにな

も使用できる。

並作用金属の表面に設ける誘電体酸化皮膜は、並作用金属の表面部分に設けられた並作用金属自体の酸化物層であってもよく、或いは、並作用金属の表面上に設けられた他の誘電体酸化物の層であってもよいが、特に並作用金属自体の酸化物からなる層であることが好ましい。いずれの場合にも酸化物層を設ける方法としては、電解液を用いた陽極化成法など従来公知の方法を用いることができる。

次に、本発明で用いられる酸化剤としては、過硫酸アンモニウム、過硫酸カリウム、過硫酸ナトリウム等の過硫酸塩、 $FeCl_3$ 、 $AlCl_3$ 、 $SnCl_4$ 、塩素酸塩、過塩素酸塩、次亜塩素酸塩、過マンガン酸塩、クロム酸塩等が挙げられるが、とりわけ過硫酸塩が公害等の問題も無く、水に可溶であり、工業的に利用しやすいため好都合である。並作用金属を酸化剤で処理する方法は、例えば酸化剤を含有する溶液に並作用金属を浸漬し、引き上げて乾燥する方法が挙げられる。或いは酸化剤を

含有する溶液を作用金属に噴霧して処理してもよく、一般に塗化剤を作用金属に均一に付着させればよい。

次に、本発明で用いられるモノマーは、前記の一般式(1)の構造を有するものである。

代表例としてチオフェン、ピロール、フラン、N-メチルピロール、3-メチルチオフェン等が挙げられる。これらのモノマーを2種以上使用してもよい。塗化剤で処理された表面に誘導体酸化皮膜層を有する作用金属を、モノマーを溶解した電解液中に浸漬し、別に用意した陰極と電解反応を行うことによって、作用金属の表面に高分子化合物が析出する。この場合、電解液中の冠解質イオンがドーパントとなるため電解と同時に電導性高分子化合物である半導体となる。又、本発明で用いられる作用金属は均一に塗化剤処理がなされているため、電解反応と同時に化学反応も生じる結果、電解反応時間は短時間にすることができる。しかも化学反応した部分部分が各々微小な時に電解反応が起るため、化学反応層と電解反応層との界面抵抗もわずかなものとなる。

て使用してもよい。

本発明に用いる固体電解質は電導度が $10^0 \sim 10^2 \text{ S} \cdot \text{cm}^{-1}$ オーダーのものが得られ、電導度が高い程、作製した固体電解コンデンサの高周波でのDFが低く良好なものとなる。

本発明の方法による固体電解コンデンサは、上述した固体電解質層の上にカーボンペースト又はノルベースト等で陰極層を取り出し、更に樹脂やケース等、従来公知の方法で封口して製品とされる。

#### [作用]

塗化剤で処理した作用金属を電解液中に浸漬して電解反応すると、電解反応と同時に化学反応も生じ、その結果、電解反応時間が短時間となる。しかも、化学反応した部分部分が各々微小な時に電解反応が起り、化学反応層と電解反応層との界面抵抗もわずかなものとなる。従って作製した固体電解コンデンサのDFは低く良好なものとなる。

#### [実施例]

合層との界面抵抗もわずかなものとなる。

本発明に使用する電解液は従来公知の冠解液を使用することができる。例えば、プロピレンカーポネート、エチレンカーポネート、アーブチロラクトン、アセトニトリル、ジメチルホルムアミド、スルフォラン、メチルスルホキシド、ニトロメタン、水等の溶媒にI<sup>-</sup>、Cl<sup>-</sup>、F<sup>-</sup>、Br<sup>-</sup>、ClO<sub>4</sub><sup>-</sup>、BF<sub>4</sub><sup>-</sup>、AsF<sub>6</sub><sup>-</sup>、PF<sub>6</sub><sup>-</sup>、FeCSO<sub>4</sub><sup>-</sup>、BCl<sub>4</sub><sup>-</sup>、NO<sub>2</sub><sup>-</sup>、POF<sub>3</sub><sup>-</sup>、CN<sup>-</sup>、SiF<sub>6</sub><sup>-</sup>、CH<sub>3</sub>COO<sup>-</sup>、C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>COO<sup>-</sup>、CH<sub>3</sub>C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>SO<sub>4</sub><sup>-</sup>、C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>SO<sub>4</sub><sup>-</sup>、SO<sub>4</sub><sup>-</sup>、SIP<sub>6</sub><sup>-</sup>、BF<sub>3</sub><sup>-</sup>等のアルカリ金属塩もしくはハログンイオンを除いてアンモニウム塩からなる冠解質を溶解したものである。

又、前述した電導性高分子化合物にさらにドーパントとしてI<sub>2</sub>、Br<sub>2</sub>、SO<sub>2</sub>、AsF<sub>5</sub>、SbF<sub>5</sub>、トルエンスルファン酸、ベンゼンスルファン酸等の電子受容体を化学的方法を用いてドープするか、あるいは、BF<sub>4</sub><sup>-</sup>、ClO<sub>4</sub><sup>-</sup>、PF<sub>6</sub><sup>-</sup>、AsF<sub>6</sub><sup>-</sup>、トルエンスルファン酸イオン、ベンゼンスルファン酸イオン等のアニオンを電気化学的方法を用いてドープし

以下、実施例及び比較例を示して説明する。

#### 実施例 1～6

りん酸とりん酸アンモニウム水溶液中で化成処理して表面に誘導体酸化皮膜層を形成した $10 \mu\text{m}$  F/cmolのアルミニウムエッティング箔（以下化成箔と称する）の小片 $0.5\text{cm} \times 0.5\text{ cm}$ を120枚用意し、各実施例にそれぞれ20枚ずつ使用した。表1に記載したそれぞれの塗化剤溶液中に化成箔を浸漬し引き上げた。更に、表1に記載されたモノマーを0.2モル溶解させた0.05MBu<sub>4</sub>NBF<sub>4</sub>アセトニトリル溶液中に前述した塗化剤処理液の化成箔を浸漬し電解反応を行った。約1時間後、化成箔上に形成された電導性高分子化合物を水で充分洗浄した後、乾燥した。形成された固体電解質の電導度は、およそ $10 \sim 200 \text{ S} \cdot \text{cm}^{-1}$ であった。次に固体電解質層を形成した化成箔に銀ベーストで陰極層を形成した後、樹脂封口して固体電解コンデンサを作製した。

(以下余白)

表 1

	モノマー	酸化剤
実施例 1	ビロール	過硝酸アンモニウム 20%水溶液
〃 2	N-メチル ビロール	過硫酸アンモニウム 20%水溶液
〃 3	3-メチル チオフェン	過硫酸アンモニウム 20%水溶液
〃 4	フラン	塩化鉄 10%アルコール溶液
〃 5	チオフェン	塩化鉄 10%アルコール溶液
〃 6	ビロール	過硫酸カリ 5%水溶液

## 比較例 1 ~ 2

実施例と同様の化成箱を40枚用意し、各比較例に20枚づつ使用した。比較例 1 は、酸化剤処理を

表 2

体電解コンデンサを作製することができる。

	容量 $\mu F$	D F *	D F **
実施例 1	2.2	0.8	3.8
〃 2	2.0	0.8	4.1
〃 3	1.9	0.9	5.8
〃 4	1.9	0.9	5.9
〃 5	1.9	1.0	6.1
〃 6	2.1	0.8	4.3
比較例 1	1.4	1.5	8.8
〃 2	2.1	1.2	15.4

\* 120Hzでの値

\*\* 10kHzでの値

## 【発明の効果】

以上説明したように、本発明の固体電解コンデンサの製造方法によれば、電解重合によって半導体層を形成する前に、酸化剤処理を行うので、電解重合時間が短くてすみ、かつ D F 値の良好な固

せずに実施例 1 の電解液中で 3 時間、電解重合を行った場合、比較例 2 は、実施例 1 の酸化剤処理を行い、更に続けて室温でビロールモノマー蒸気にて化学重合を行った後、実施例 1 の電解液中で 1 時間、電解重合を行った場合であり、この 2 通りの方法で半導体層を形成した。引き続き実施例と同様にして陰極層を形成し樹脂封口して固体電解コンデンサを作製した。

以上作製した固体電解コンデンサの性能を表 2 に示した。

(以下余白)

特許出願人 昭和电工株式会社  
代理人 弁理士 寺田 實